Документ полтисан простой алектронной полтиской и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 31.07.2023 14:21:09 **высшего образования**

Уникальный профрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Физические основы электроники

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 7

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 57

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
Недель	18			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Практические	17	34	17	34
Итого ауд.	51	68	51	68
Контактная работа	51	68	51	68
Сам. работа	57	31	57	31
Итого	108	99	108	99

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx cтр. 2

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ
1.1	Ознакомить с физическими принципами работы основных приборов твердотельной микро-и наноэлектроники. Дать представление о многообразии различных полупроводниковых приборов и активных элементов микроэлектроники,показать тенденции их развития.
1.2	. Научить пониманию взаимосвязи различных физических характеристик исходного материала и параметров прибора

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
	Блок ОП: Б1.В.ДВ.05				
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:				
2.1.1	Биполярные полупроводниковые приборы				
2.1.2	Квантовая и оптическая электроника				
2.1.3	Материаловедение полупроводников и диэлектриков				
2.1.4	Технология материалов электронной техники				
2.1.5	Физика диэлектриков				
2.1.6	Физика конденсированного состояния				
2.1.7	Физика магнитных явлений				
2.1.8	Статистическая физика				
2.1.9	Физические свойства кристаллов				
2.1.10	Методы математической физики				
2.1.11	Основы квантовой механики				
2.1.12	Практическая кристаллография				
2.1.13	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений				
2.1.14	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений				
2.1.15	Физика				
2.1.16	Физическая химия				
2.1.17	Электротехника				
2.1.18	Математика				
2.1.19	Органическая химия				
2.1.20	Информатика				
2.1.21	Химия				
2.1.22	Инженерная и компьютерная графика				
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:				
2.2.1	Вакуумная и плазменная электроника				
2.2.2	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике				
2.2.3	Магнитные измерения				
2.2.4	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики				
2.2.5	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники				
2.2.6	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики				
2.2.7	Основы технологии электронной компонентной базы				
2.2.8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				
2.2.10	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы				
2.2.11	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы				
2.2.12	Приборы квантовой и оптической электроники				
2.2.13	Процессы вакуумной и плазменной электроники				
2.2.14	Светоизлучающие полупроводниковые приборы				
2.2.15	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики				